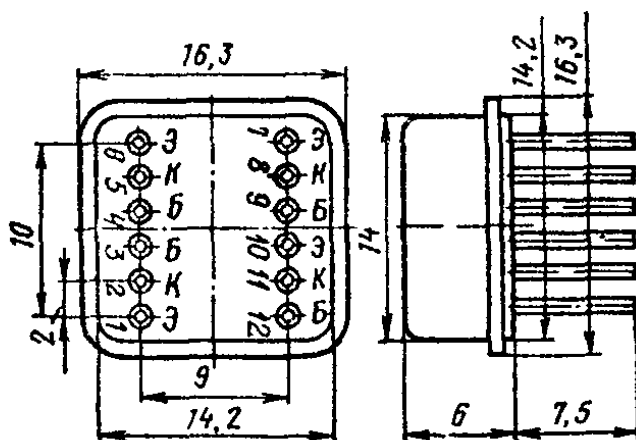


p-n-p

1ТС609А—1ТС609В, ГТС609А—ГТС609В

Транзисторные матрицы, состоящие из четырех электрически изолированных германиевых сплавно-диффузионных p-n-p переключающих сверхвысокочастотных транзисторов. Предназначены для применения в переключающих схемах.

Корпус металлостеклянный с гибкими выводами. Масса матрицы не более 4 г.



Электрические параметры

Параметр	Буквенное обозначение	Значение			Режим измерения			
		минимальное	типовое	максимальное	$U_{КЭ}(U_{КБ}), В$	$U_{ЭБ}, В$	$I_{К}, А$	$I_{Э} А(I_{Б}, мА)$
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ*, МГц	$f_{гр}$	60			3		0,5	
Граничное напряжение, В	$U_{КЭО гр}$	30	40*	54*				0,5
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер, В:	$U_{КЭ нас}$							
1ТС609А, ГТС609А		0,24*	0,74*	1,6			0,5	(70)
1ТС609Б, 1ТС609В, ГТС609Б, ГТС609В		0,24*	0,74*	1,6			0,5	(40)
Напряжение насыщения база — эмиттер, В:	$U_{БЭ нас}$							
1ТС609А, ГТС609А		0,34*	0,57*	1,1			0,5	(70)
1ТС609Б, 1ТС609В, ГТС609Б, ГТС609В		0,34*	0,57*	1,1			0,5	(40)
Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ:	$h_{21Э}$							
$T=20^{\circ}C$								
1ТС609А		33		100	(3)			0,5
1ТС609Б		53	—	160	(3)			0,5
1ТС609В		40	—	120	(3)			0,5
1ТС609А		33*			(3)			0,25
1ТС609Б		53*			(3)			0,25
1ТС609В		80			(3)			0,25
1ТС609А — 1ТС609В		15			(5)			0,7
ГТС609А		30	—	100	(3)			0,5
ГТС609Б		50	—	160	(3)			0,5
ГТС609В		80	—	240	(3)			0,5
$T=-60^{\circ}C$ и $+70^{\circ}C$								
1ТС609А—1ТС609В		$0,5h_{21Э}$		$2h_{21Э}$	(3)			0,5
$T=-40^{\circ}C$ и $+60^{\circ}C$								
ГТС609А — ГТС609В		при $T=20^{\circ}C$		при $T=20^{\circ}C$				
Время включения, мкс:	$t_{вкл}$							
1ТС609А, ГТС609А		0,021*	0,048*	0,1			0,5	(70)
1ТС609Б, 1ТС609В, ГТС609Б, ГТС609В		0,021*	0,048*	0,1			0,5	(40)
Время рассасывания, мкс:	$t_{рас}$							
1ТС609А, ГТС609А		0,122*	0,438*	0,7			0,5	(70)
1ТС609Б, 1ТС609В, ГТС609Б, ГТС609В		0,122*	0,438*	0,7			0,5	(40)
Емкость коллекторного перехода ($f=5$ МГц), пФ	$C_{К}$	17*	19,8*	50	(10)			
Емкость эмиттерного перехода ($f=5$ МГц), пФ	$C_{Э}$	63*	111,6*	250		0,5		

Параметр	Буквенное обозначение	Значение			Режим измерения			
		минимальное	типовое	максимальное	$U_{КЭ}$ (U _{КБ}), В	$U_{ЭБ}$, В	$I_{К}$, А	$I_{Э}$, А (I _Б , мА)
Обратный ток коллектора, мкА: $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ITC609A — ITC609B ГТС609A — ГТС609B $T=-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ ITC609A — ITC609B $T=60\text{ }^{\circ}\text{C}$ ГТС609A — ГТС609B $T=70\text{ }^{\circ}\text{C}$ ITC609A — ITC609B	$I_{КБО}$	5*	8,3*	30 40 30 600 500	(30) (30) (30) (30) (30)			
Обратный ток эмиттера, мкА: $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ITC609A — ITC609B ГТС609A — ГТС609B $T=-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ ITC609A — ITC609B $T=60\text{ }^{\circ}\text{C}$ ГТС609A — ГТС609B $T=70\text{ }^{\circ}\text{C}$ ITC609A — ITC609B	$I_{ЭБО}$	1,1*	2,9*	100 200 100 1000 500		2,5 2,5 2,5 2,5 2,5		

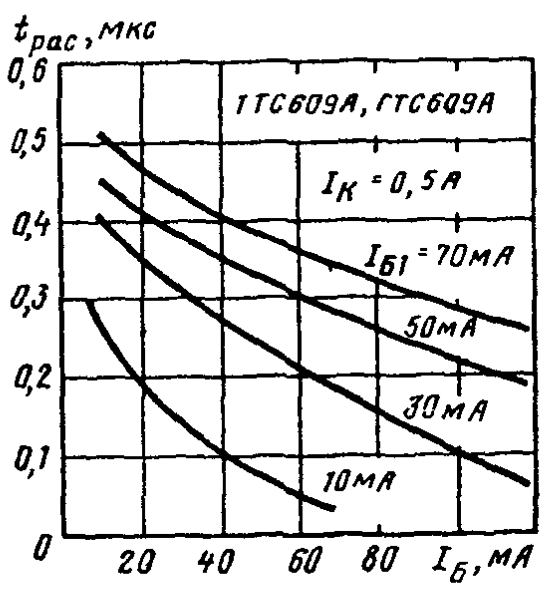
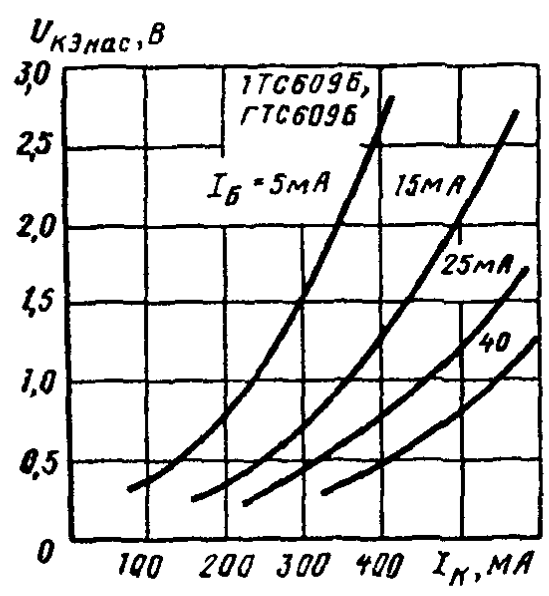
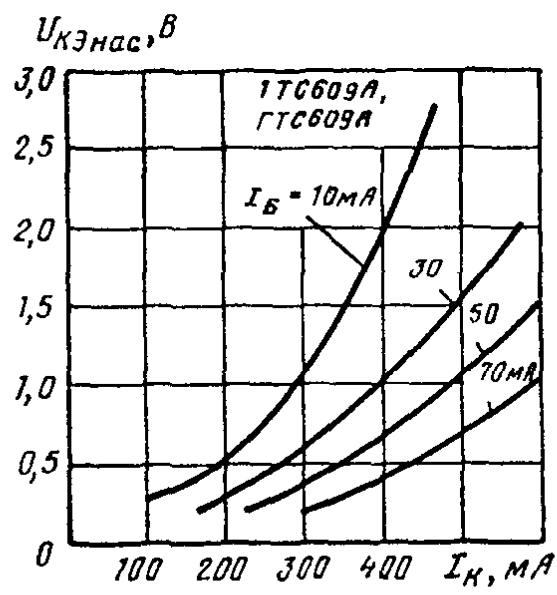
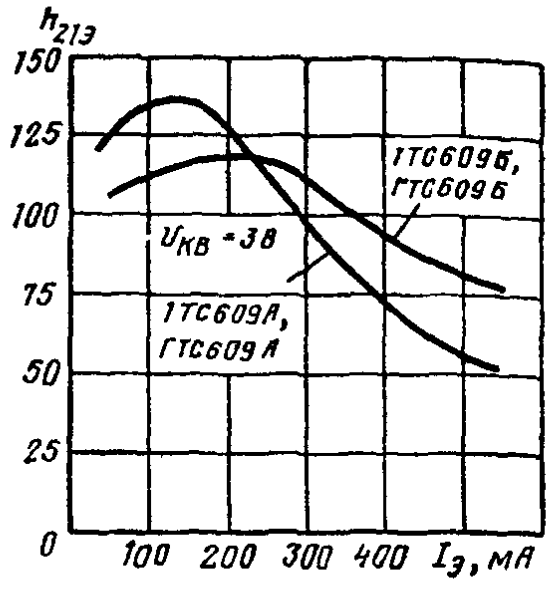
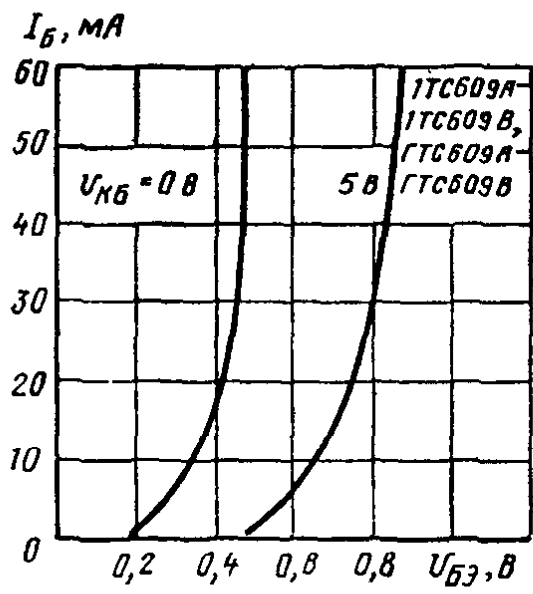
Предельные эксплуатационные данные

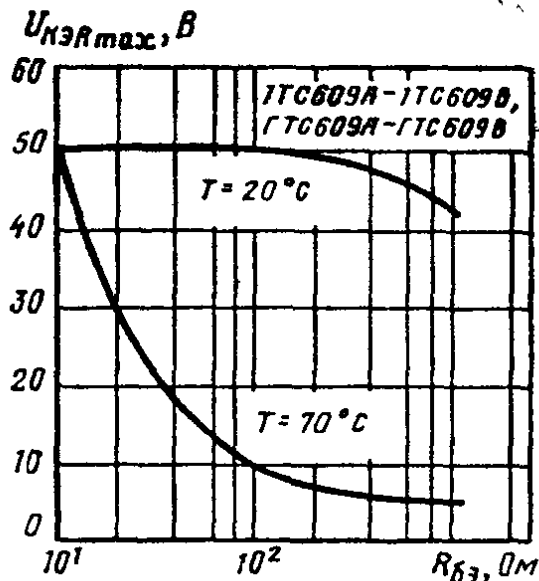
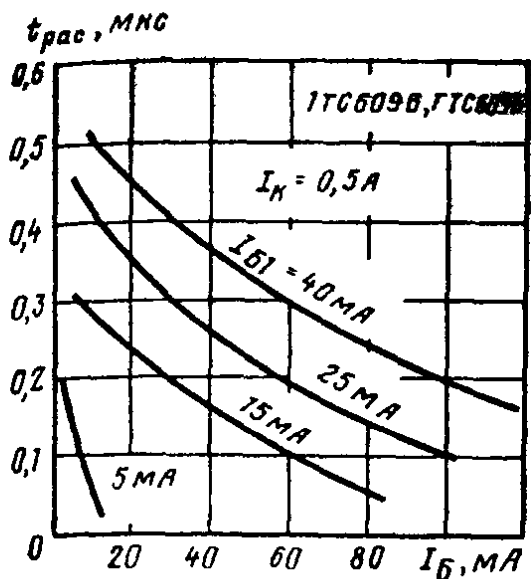
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер ($U_{ЭВ} = 0,5-0,7$ В)	50 В
Постоянное напряжение коллектор — база	50 В
Постоянное напряжение эмиттер — база	2,5 В
Импульсное напряжение эмиттер — база ($\tau_{и} \leq 10$ мкс, $Q \geq 2$) ¹	3 В
Импульсный ток коллектора ($\tau_{и} \leq 10$ мкс, $Q \geq 2$) ²	0,7 А
Импульсный ток базы ($\tau_{и} \leq 10$ мкс, $Q \geq 2$) ²	0,1 А
Постоянная рассеиваемая мощность всех структур матрицы ($T \leq 43\text{ }^{\circ}\text{C}$) ³	500 мВт
Импульсная рассеиваемая мощность одного транзистора матрицы ($\tau_{и} \leq 10$ мкс)	5 Вт
Тепловое сопротивление переход — среда	0,084 $^{\circ}\text{C}/\text{мВт}$
Температура перехода	85 $^{\circ}\text{C}$
Температура окружающей среды:	
ITC609A — ITC609B	-60 ÷ +70 $^{\circ}\text{C}$
ГТС609A — ГТС609B	-40 ÷ +60 $^{\circ}\text{C}$

¹ Сумма постоянного и импульсного напряжений эмиттер — база не должна превышать 3 В.

² Значение тока для одного элемента матрицы при условии непревышения мощности, рассеиваемой матрицей.

³ При $T \geq 43\text{ }^{\circ}\text{C}$ $P_{\max} [\text{мВт}] = (85 - T) / R_{Тп}$, с.

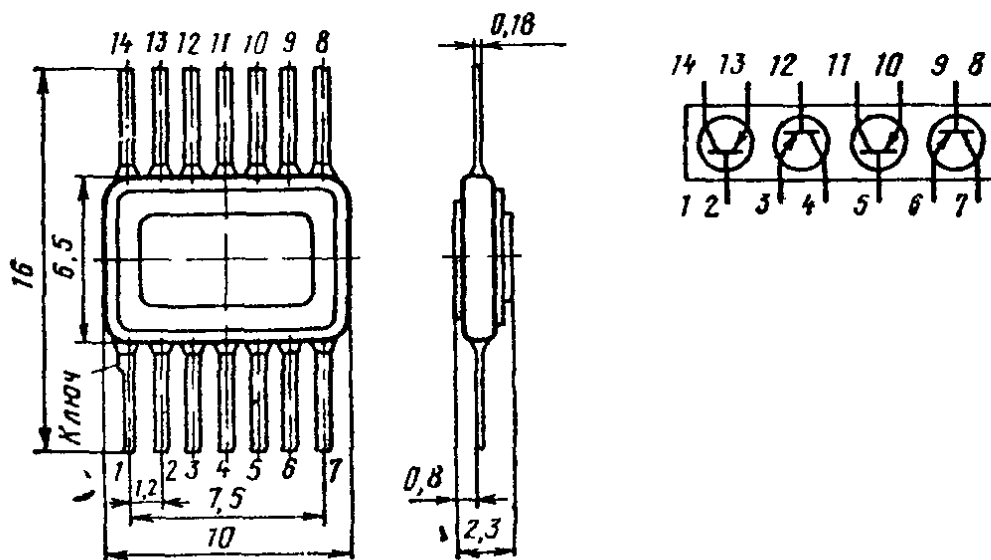




2ТC622А, 2ТC622Б, КТC622А, КТC622Б

Триазисторные матрицы, состоящие из четырех электрически изолированных кремниевых эпитаксиально-планарных *p-n-p* переключающих сверхвысокочастотных триазисторов, предназначены для применения в быстродействующих импульсных и переключающих устройствах.

Корпус металлокерамический с гибкими выводами. Масса матрицы не более 0,4 г.



Пайку выводов разрешается производить на расстоянии не менее 1 мм от корпуса.